









	<p>SI3433CDV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3433CDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3433CDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41984 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3433CDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41984 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6A (Tc) 1.6W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	38 mOhm @ 5.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3433CDV-T1-E3-ND

SI3433CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3433CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3433CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3433CDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3433DN VISHAY SI3433DN VISHAY</p>	 <p>SI3433CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433CDV-T1 VISHAY SI3433CDV-T1 VISHAY</p>
 <p>SI3433DBV-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-336</p>	 <p>SI3433CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3424BDV-T1-E3	SI3424BDV-T1-E3	SI3424BDV-T1-GE3	SI3424BDV-T1-GE3	SI3424CDV
SI3424CDV-T1-E3	SI3424CDV-T1-GE3	SI3424CDV-T1-GE3	SI3424DV-T1	SI3424DV-T1-E3
SI3424DV-T1-E3	SI3424DV-T1-GE3	SI3424DV-T1-GE3	SI3424DV-TI-E3	SI3425DV
SI3429EDV-T1-GE3	SI3429EDV-T1-GE3	SI3430DV-T1	SI3430DV-T1-GE3	SI3430DV-T1-GE3
SI3433BDV-T1	SI3433BDV-T1-E3	SI3433BDV-T1-E3	SI3433BDV-T1-GE3	SI3433BDV-T1-GE3
SI3433CDV-T1-E3	SI3433CDV-T1-GE3	SI3433CDV-T1-GE3	SI3433DN	SI3433DV-T1
SI3433DV-T1-E	SI3433DV-T1-E3	SI3433DV-T1-GE3	SI3434DV-T1	SI3434DV-T1-E3
SI3434DV-T1-E3	SI3434DV-T1-GE3	SI3434DV-T1-GE3	SI3435DV-T1	SI3435DV-T1-E3
SI3435DV-T1-GE3	SI3437DV-T1-E3	SI3437DV-T1-E3	SI3437DV-T1-GE3	SI3437DV-T1-GE3
SI3438DV-T1-E3	SI3438DV-T1-E3	SI3438DV-T1-GE3	SI3438DV-T1-GE3	SI3440ADV-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited